



## 性能指标

	28nm 工艺, 尺寸: 7mm×5.9mm
通用特性	工作温度: -40~85°C 存储温度: -55~125°C 基带射频一体化设计 SIP Flash SIP PSRAM (可选) SIP PMIC
主控处理器	RISC-V, 最高主频 600MHz
DSP 处理器	最高主频 400MHz
内存	16KB ROM 1.5MB On-chip SRAM
启动模式	支持 Flash 程序启动 支持 UART 启动 支持安全模式, 支持 AES/ SHA/ ECC 等安全启动
基带调制 解调器	支持天通卫星通信制式 支持 XW 窄带通信制式
时钟	支持系统时钟输入 (26MHz/19.2MHz) 支持 32K RTC 时钟输入
低功耗	支持 DRX 低功耗模式
接口	USB/UART/GPIO/I2C/SDIO/12S/USIM



## 应用领域

HTD3100 芯片体积小、功耗低、集成度高, 可适应各种需要。主要面向于大规模应用场景, 例如大众消费、汽车、应急救生、低空经济等行业市场, 主要支持语音、短信、物联网、数据业务功能。